



2SB1189 (3CG1189)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途：用于中功率放大。

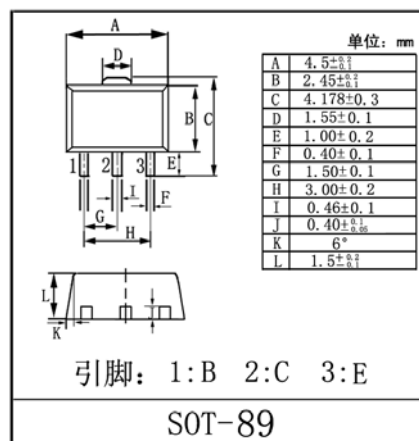
Purpose: Medium power amplifier applications.

特点:饱和压降低, 与 2SD1767 (3DG1767) 互补。

Features: Low $V_{CE(sat)}$, complements the 2SD1767 (3DG1767).

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	-80	V
V_{CE0}	-80	V
V_{EB0}	-5	V
I_C	-0.7	A
P_C	0.5	W
* P_C	2	W
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



*:mounted on $40 \times 40 \times 0.7\text{mm}$ ceramic board.

*:装于 $40 \times 40 \times 0.7\text{m}$ 的陶瓷板上。

电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C = -50 \mu\text{A}$ $I_E = 0$	-80			V
V_{CE0}	$I_C = -2\text{mA}$ $I_B = 0$	-80			V
V_{EB0}	$I_E = -50 \mu\text{A}$ $I_C = 0$	-5			V
I_{CB0}	$V_{CB} = -50\text{V}$ $I_E = 0$			-0.5	μA
I_{EB0}	$V_{EB} = -4\text{V}$ $I_C = 0$			-0.5	μA
h_{FE}	$V_{CE} = -3\text{V}$ $I_C = -0.1\text{A}$	82		390	
$V_{CE(sat)}$	$I_C = -500\text{mA}$ $I_B = -50\text{mA}$		-0.2	-0.4	V
f_T	$V_{CE} = -10\text{V}$ $I_E = 50\text{mA}$ $f = 100\text{MHz}$		100		MHz
C_{ob}	$V_{CB} = -10\text{V}$ $I_E = 0$ $f = 1\text{MHz}$		14	20	pF

h_{FE} 分档、印章/ h_{FE} Classifications、Marking:

h_{FE} 分档/ h_{FE} Classifications	P	Q	R
h_{FE} 范围/ h_{FE} Range	82~180	120~270	180~390
印章/Marking	HB DP *	HB DQ *	HB DR *

